

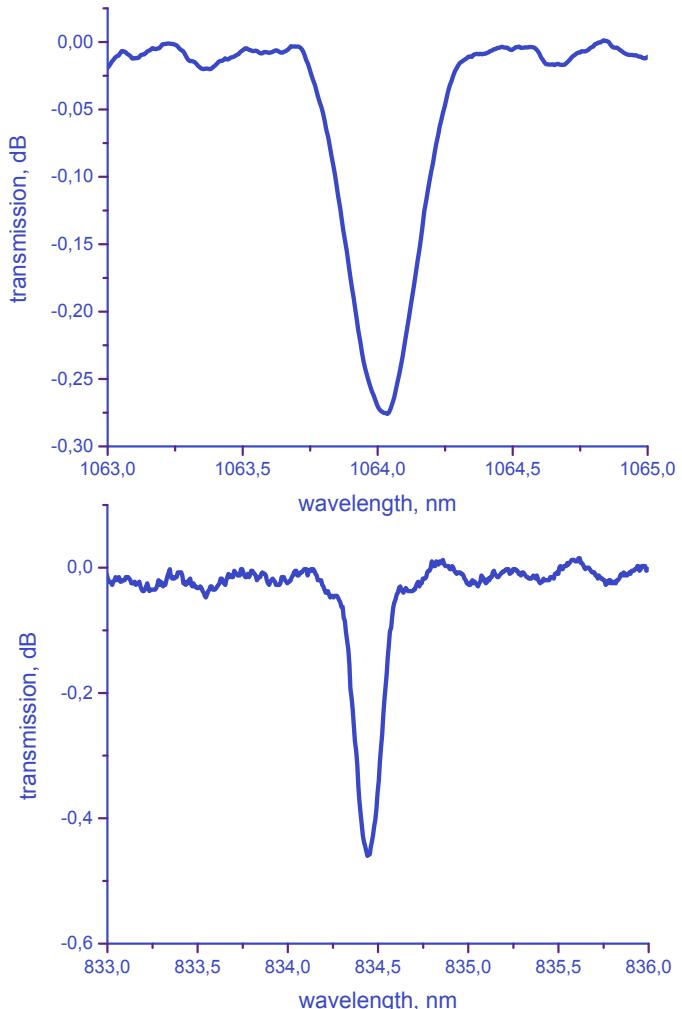
ВБР ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

ARTICLE GTL-FBG-WL-810

Использование ВБР, состыкованных с полупроводниковыми лазерными диодами, позволяет стабилизировать длину волны излучения диодов накачки или получать одночастотный режим генерации.

Для стабилизации длины волны применяют слабо отражающие решетки с FWHM 0.3 нм – 0.8 нм и коэффициентом отражения 2% – 5 %. Решетки расположенные вплотную к лазерному кристаллу с FWHM около 0.1 нм и отражением 10% - 20% применяются для получения одночастотных режимов работы полупроводниковых лазеров. Мы изготавливаем решетки с точностью по длине волны отражения до ± 0.02 nm. На рисунках представлены спектры пропускания таких решеток.

ВБР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЛИНЫ ВОЛНЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ	GTL-FBG-WL-810	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ/ПРИМЕЧАНИЕ
Диапазон длин волн, нм	633, 650, 852, 976, 1030, 1060, 1064, 1080, 1125, 1150, 1510 ÷ 1580, 1551, 1650	$\pm 0.1 \div \pm 1$
Тип световода	Одномодовое, С поддержкой поляризации	или по запросу
Отражательная способность, %	2 ÷ 5 / 10 ÷ 20	0.5 ÷ 1 / 1 ÷ 2
Спектральная ширина (Полная ширина по полувысоте отражения), нм	0.3 ÷ 0.8 / 0.1 ÷ 0.15	выбрать нужное значение
Отношение уровня боковых максимумов к центральному пику отражения, дБ	~ 10	выбрать нужное значение
Длина участка световода от решетки, м	≥ 0.5	или по запросу
Восстановление покрытия	Без перепокрытия, Акрилатное, Полиимидное, Алюминиевое, Медное	или по запросу
Предел прочности, kpsi	> 100	
Оптический соединительный разъём	Без разъема, FC/APC, LC/APC	или по запросу

Конфигурация может быть изменена по желанию заказчика. Параметры, указанные в данной спецификации, могут быть изменены в соответствии с техническим заданием.